Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. диодных матриц

Золото 6,8378 г., в т. ч. на выводах 4,6689 г.

Серебро 0,55 г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Диодные матрицы типов 2Д906А1/ББ, 2Д906Б1/ББ, 2Д906В1/ББ соответствуют техническим условиям АЕЯР.432120.185 ТУ.

Приняты по извещению № 165 от 13.05
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

ОТК-140

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»
дата

Принято по извещению № _____ от _____
дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

conelectro.by

Диодная матрица
2Д906А1/ББ,
2Д906Б1/ББ,
2Д906В1/ББ.

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарно-эпитаксиальные диодные матрицы типов 2Д906А1/ББ, 2Д906Б1/ББ, 2Д906В1/ББ, состоящие из четырех элементов, предназначены для работы в качестве выпрямительного моста или резервированного диода в специальных радиотехнических и электронных устройствах.

Схема расположения выводов

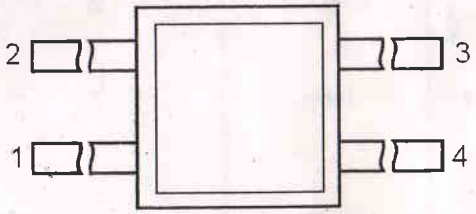
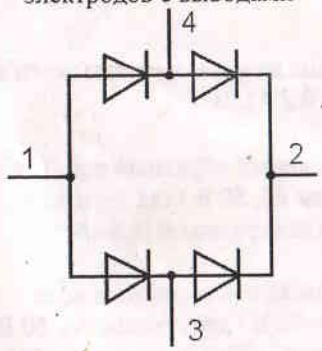


Схема соединения электродов с выводами



Диодные матрицы типов 2Д906А1/ББ, 2Д906Б1/ББ, 2Д906В1/ББ маркируются белой полосой у четвертого вывода.

Дополнительно ставится:

- у диодной матрицы 2Д906Б1/ББ – одна красная точка на боковой стороне;
- у диодной матрицы 2Д906В1/ББ – две красные точки на боковой стороне.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
(при $t_{окр}$ =25±10°С)

именование параметра, режим измерения, иница измерения	Буквенное обозначение	Норма не более
стоянное прямое напряжение р. = 50 мА), В	Uпр.	1
тановившееся прямое напряжение р.ср. = 30 мА; Iпр.и = 2 А; τи = 10 мкс), В	Uпр.уст.	2
мпульсное прямое напряжение р.ср. = 30 мА; Iпр.и = 2 А; τи = 10 мкс), В	Uпр.и.	5
обивное напряжение (Iобр. = 50 мкА), В	Uпроб.	≥ 100 (для группы А) ≥ 75 (для групп Б и В)
ямое напряжение короткого замыкания = 0,2 А), В	Uпр.к.з.	2
стоянный обратный ток (Uобр. = 75 В (для уппы А), 50 В (для группы Б), В (для группы В)), мкА	Iобр.	2
ратный ток холостого хода м. = 75 В (для группы А), 50 В (для ппы Б), 30 В (для группы В)), мкА	Iобр.х.х.	5
емя обратного восстановления ос. = 5 мА, Uобр. = 20 В, .и. = 0,2 А; RΣ = 600 Ом), мкс	tвос.обр.	0,4
емя прямого восстановления (Iпр.и. = 2 А; .ср. = 30 мА, τи. = 10 мкс), мкс	tвос.пр	1
щая емкость (Uобр. = 5 В), пФ	Сд	20

Примечание: Все параметры для каждого элемента диодной матрицы.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Разрешается применение диодных матриц в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии непосредственно в аппаратуре лаками (в 3-4 слоя) типа УР-231 ТУ 6-10-863 (с добавлением фунгицида: паранитрофенол (ТУ 6-09-3973)) или ЭП-730 ГОСТ 20824 (с добавлением фунгицида: паранитрофенол ГОСТ 20824 (ТУ 6-09-3973)).

2. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода не менее 2,0 мм с радиусом закругления не менее 0,7 мм.

При использовании диодной матрицы в качестве резервированного диода допускается удаление выводов 3 и 4 на расстоянии не менее 0,3 мм от корпуса при сохранении целостности конструкции, при исключении скручивающих и изгибающих усилий, при этом величина усилия натяжения не должна превышать 0,1 кгс.

3. Разрешается соединение диодных матриц с элементами аппаратуры различными способами на расстоянии не менее 3 мм от корпуса диодных матриц, исключающими нагрев корпуса диодной матрицы выше 150°С и прохождение импульсов электрического тока через элементы диодных матриц.

Пайку производить оловянно-свинцовым припоем при температуре пайки не выше (260±5) °С в течение 2-3 с без применения теплоотвода.

Допускается производить пайку при температуре до 275 °С с применением теплоотвода. В качестве теплоотвода рекомендуется применять пинцет с плоскими медными губками шириной не менее 2 мм и толщиной не менее 1 мм.

Допускается пайка на расстоянии не менее 1 мм от корпуса диодной матрицы к металлической детали площадью не менее 7,0 мм^2 оловянно-свинцовым припоем при температуре не выше 200 °С, при этом допускается затекание припоя до герметизирующего материала.

Отмывку флюса после пайки рекомендуется производить спиртом в течение 1 минуты.

ky.lotcenter